

SuperSOT

SOT23 NPN SILICON POWER

(SWITCHING) TRANSISTORS

ISSUE 3 - NOVEMBER 1995

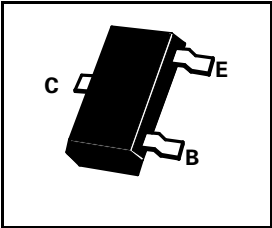
FMMT617 FMMT618

FMMT619 FMMT624

FMMT625

FEATURES

- * **625mW POWER DISSIPATION**
- * **I_C CONT 3A**
- * 12A Peak Pulse Current
- * Excellent H_{FE} Characteristics Up To 12A (pulsed)
- * Extremely Low Saturation Voltage E.g. 8mV Typ.
- * Extremely Low Equivalent On Resistance; **R_{CE(sat)}**



DEVICE TYPE	COMPLEMENT	PARTMARKING	R _{CE(sat)}
FMMT617	FMMT717	617	50mΩ at 3A
FMMT618	FMMT718	618	50mΩ at 2A
FMMT619	FMMT720	619	75mΩ at 2A
FMMT624	FMMT723	624	-
FMMT625	—	625	-

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	FMMT 617	FMMT 618	FMMT 619	FMMT 624	FMMT 625	UNIT
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	15	20	50	125	150	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	15	20	50	125	150	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	5	5	5	5	5	V
Peak Pulse Current**	I _{CM}	12	6	6	3	3	A
Continuous Collector Current	I _C	3	2.5	2	1	1	A
Base Current	I _B	500					mA
Power Dissipation at T _{amb} =25°C*	P _{tot}	625					mW
Operating and Storage Temperature Range	T _j :T _{stg}	-55 to +150					°C

* Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on a ceramic substrate measuring 15x15x0.6mm

**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

Spice parameter data is available upon request for these devices

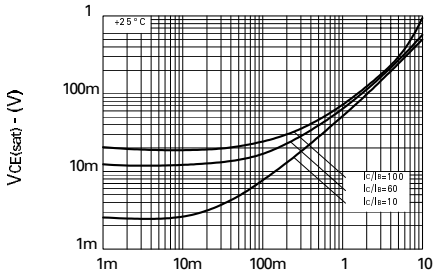
FMMT617

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	15	70		V	$I_C = 100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	15	18		V	$I_C = 10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	8.2		V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			100	nA	$V_{CB} = 10\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			100	nA	$V_{EB} = 4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}			100	nA	$V_{CES} = 10\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		8 70 150	14 100 200	mV mV mV	$I_C = 0.1\text{A}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 1\text{A}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 3\text{A}, I_B = 50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.9	1.0	V	$I_C = 3\text{A}, I_B = 50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.84	1.0	V	$I_C = 3\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	200 300 200 150	415 450 320 240 80			$I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 200\text{mA}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 3\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 5\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 12\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	80	120		MHz	$I_C = 50\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		30	40	pF	$V_{CB} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		120		ns	$V_{CC} = 10\text{V}, I_C = 3\text{A}$ $I_{B1} = I_{B2} = 50\text{mA}$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		160		ns	

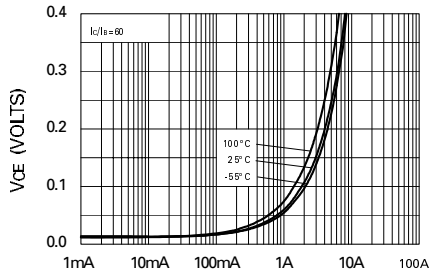
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

TYPICAL CHARACTERISTICS



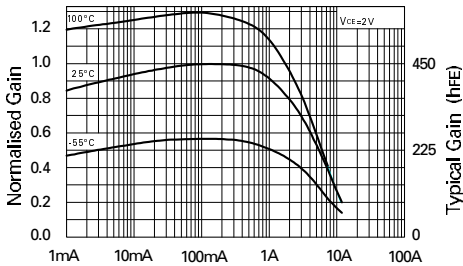
I_C - Collector Current (A)

$V_{CE(SAT)}$ v I_C



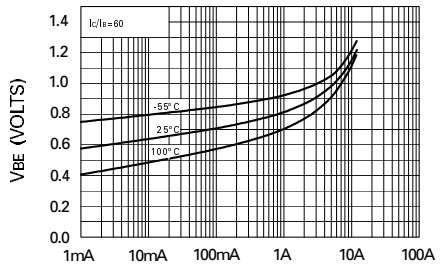
Collector Current

$V_{CE(SAT)}$ vs I_C



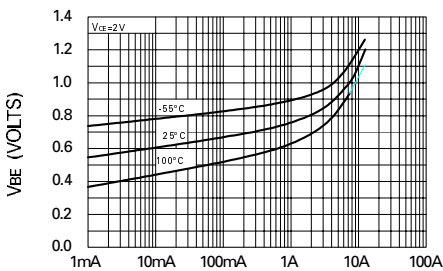
Collector Current

h_{FE} vs I_C



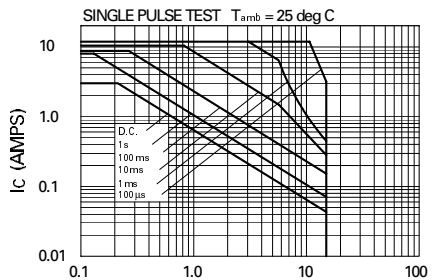
Collector Current

$V_{BE(SAT)}$ vs I_C



Collector Current

$V_{BE(ON)}$ vs I_C



V_{CE} (VOLTS)

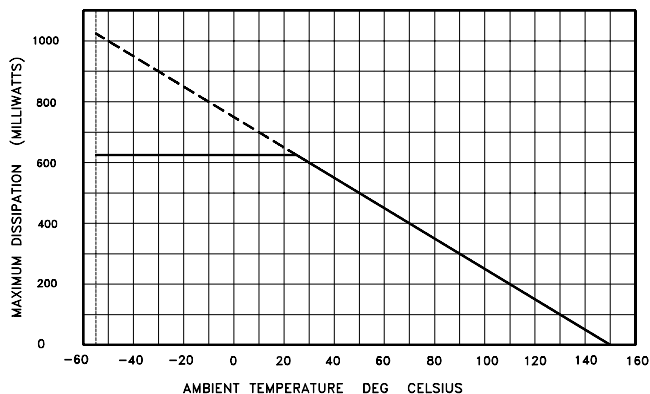
Safe Operating Area

FMMT617 FMMT624
FMMT618 FMMT625
FMMT619

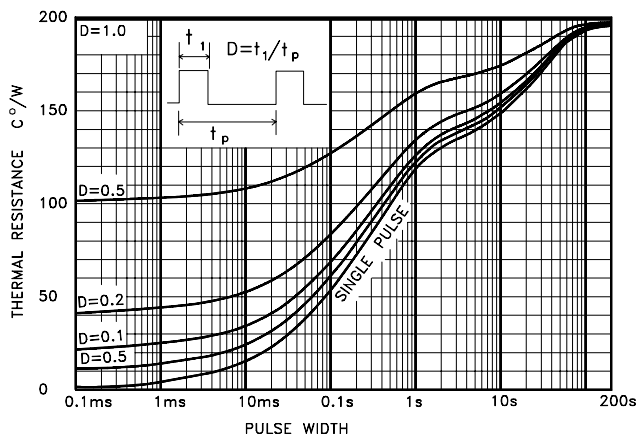
SuperSOT Series

FMMT717 FMMT722
FMMT718 FMMT723
FMMT720

THERMAL CHARACTERISTICS AND DERATING INFORMATION



DERATING CURVE



MAXIMUM TRANSIENT THERMAL RESISTANCE

* Reference above figures, Devices were mounted on a 15mmx15mm ceramic substrate

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru